PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-007072

(43) Date of publication of application: 10.01.2003

(51)Int.CI.

G11C 13/04 G02F 1/13

G11C 17/00

(21)Application number: 2001-190104

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

22.06.2001

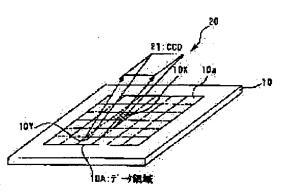
(72)Inventor: ISHIHARA HIROSHI

(54) OPTICAL MEMORY ELEMENT. REPRODUCING DEVICE FOR OPTICAL MEMORY ELEMENT AND REPRODUCING METHOD FOR OPTICAL MEMORY ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enlarge the size of an optical memory element to obtain a large capacity without being affected by the light receiving area of an photo detector provided in a drive.

SOLUTION: The optical memory element 10 consisting of a core layer made of resin and clad layers made of resin laminated on the both surfaces of the core layer made of resin and formed by laminating one or more optical waveguide members having a rugged part for information on at least one interface between the core layer made of resin and the clad layers made of resin is so constituted that an information recording area 10A having the rugged part for information is divided into a plurality of small areas 10a and all scattering light beams emitted from the plurality of small areas are imageformed on one area smaller than the information recording area to form a reproducing image.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than withdrawal

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

24.05.2005

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

REST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開2003-7072

(P2003-7072A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

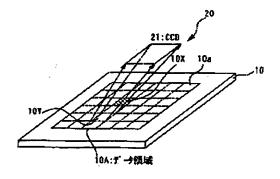
(51) Int.CL'	識別記号	FΙ	テーマユード(参考)	
G11C 13/04		G11C 13/04	B 2H088	
G02F 1/13	505	G02F 1/13	505 5B003	
G11C 17/00	580	G11C 17/00	580D	
		580E		
		水館	蔚泉項の数19 OL (全 17 頁)	
(21)出顧番号	特顧2001 190104(P2001 190104)	(71)出庭人 000005968 三変化学株式会社		
(22) 出籍日	平成13年6月22日(2001.6.22)	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号		
		(72) 班明者 石原 啓		
		神奈川県横浜市青業区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社内		
		(74)代理人 10009297	8	
		护理士	 	
	·	Fターム(参考) 2008	ターム(参考) 25088 CA33 EA62	
		58003 AA09 AC02 AC08 A004		

(54) 【発明の名称】 光メモリネ子、光メモリネ子用再生装置及び光メモリ素子の再生方法

(57)【要約】

【課題】 ドライブ内に備えられる光検出器の受光面積 の影響を受けることなく、光メモリ素子のサイズを大き くし、大容量化を図る。

【解決手段】 樹脂製コア層と、樹脂製コア層の両面に 補層された樹脂製クラッド層とからなり、樹脂製コア層 と樹脂製クラッド層との界面の少なくとも一方に情報用 凹凸部を有する光導液部材を1以上積層させてなる光メ モリ素子10であって、情報用凹凸部を有する情報記録 領域10Aを複数の小領域10aに区分し、複数の小領 域から出射される散乱光がいずれも情報記録領域よりも 小さい一の領域に結像して再生像が形成されるように枠 成する。



(2)

【特許請求の範囲】

【語求項1】 樹脂製コア層と、前記樹脂製コア層の両面に積層された樹脂製クラッド層とからなり、前記樹脂製コア層と前記樹脂製コア層と前記樹脂製クラッド層との界面の少なくとも一方に情報用凹凸部を有する光導波部村を、1以上積層させてなる光メモリ素子であって、

前記情報用凹凸部を有する情報記録領域が複数の小領域 に区分され、前記複数の小領域から出射される設乱光が いずれも前記情報記録領域よりも小さい一の領域に結像 して再生像が形成されるように構成されることを特徴と 10 する。光メモリ素子。

【語求項2】 前記情報記録領域は、前記一の領域に対向する第1の領域とそれ以外の第2の領域とからなり、前記第2の領域内の小領域から出射される散乱光の強度が、前記一の領域において前記第1の領域内の小領域から出射される散乱光の強度とほぼ同一になるように前記第2小領域の前記情報用凹凸部が形成されることを特徴とする、請求項1記載の光メモリ素子。

【語求項3】 前記一の領域に対向する第1の領域以外の第2の領域内の小領域に形成される前記情報用凹凸部 20の周期と前記第1の領域内の小領域に形成される前記情報用凹凸部の周期とが異なることを特徴とする。請求項1又は2記載の光メモリ素子。

【請求項4】 前記複数の小領域には、それぞれ異なる 再生像が得られるように前記情報用凹凸部が形成され、 前記複数の小領域から出射される散乱光によって前記一 の領域に複数の異なる再生像が形成されるように構成さ れることを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に 記載の光メモリ素子。

【詰求項5】 前記一の領域に対向する第1の領域では、前記複数の小領域のそれぞれから出射される数乱光によって前記一の領域に複数の異なる再生像が形成されるように前記信報用凹凸部が形成され、

前記第1の領域以外の第2の領域では、所定の複数の小領域から出射される散乱光が前記一の領域で結像して一の再生像が形成されるように前記情報用凹凸部が形成されることを特徴とする、請求項1記載の光メモリ素子。

【語求項6】 前記複数の小領域間には、それぞれ前記 情報用凹凸部を有しない領域が形成されていることを特 徴とする、請求項1~5のいずれか1項に記載の光メモ 40 リ素子。

【詰求項7】 前記復数の小領域同士が、一部重複していることを特徴とする、詰求項1~5のいずれか1項に記載の光メモリ素子。

【詰求項8】 詰求項1~7のいずれか1項に記載の光 メモリ素子に記録されている情報を再生すべく。前記光 メモリ素子に入射光を入射させ、外部へ出射される散乱 光を検出する光メモリ素子用再生装置であって。

前記光メモリ素子から出射され、前記一の領域に結像する散乱光を検出する光検出器と、

前記光検出器に対向する位置に配設され、前記光メモリ 素子の前記複数の小領域からそれぞれ出射される散乱光 を選択的に通過させるべく部分的に開口させうるマスク とを備えることを特徴とする、光メモリ素子用再生装

2

【請求項9】 前記複数の小領域の中のいずれか一の小領域から出射される散乱光のみを通過させるように前記マスクを部分的に開口させ、前記マスクの閉口部を通過した散乱光を前記光検出器によって検出することで、前記接数の小領域の中のいずれか一の小領域に記録されている情報を再生することを特徴とする。請求項8記載の光メモリ素子用再生装置。

【語求項10】 前記一の領域に対向する第1の領域以外の第2の領域内の小領域の中の所定の複数の小領域から出射される散乱光のみを通過させるように前記マスクの複数の部分を開口させ、前記マスクの複数の開口部を通過した前記所定の複数の小領域からの散乱光によって形成される一の再生像を前記光検出器によって検出することで、前記所定の複数の小領域に記録されている情報を再生することを特徴とする、請求項8記載の光メモリ素子用再生装置。

【請求項11】 前記小領域から出射される散乱光を通過させるべく。前記小領域よりも大きくなるように前記マスクを部分的に関口させることを特徴とする。請求項8~10のいずれか1項に記載の光メモリ素子用再生装置。

【簡求項12】 前記一の領域に対向する第1の領域内の小領域に記録されている情報を再生する際には、前記第1小領域から出射される数乱光のみを通過させるように前記マスクの前記第1小領域に対向する部分を開口させる一方、

前記第1の領域以外の第2の領域内の小領域に記録されている情報を再生する際には、前記第2小領域から出射される散乱光のみを通過させるように前記マスクの前記第2小領域に対向する部分から前記一の領域側へずれた部分を開口させることを特徴とする。 註求項8~11のいずれか1項に記載の光メモリ素子用再生装置。

【詰求項13】 前記マスクが、液晶パネルにより構成 されることを特徴とする。 請求項8~12のいずれか1 項に記載の光メモリ素子用再生装置。

【詰求項14】 請求項1~7のいずれか1項に記載の 光メモリ素子の再生方法であって、

前記光メモリ索子の光導波部材に入射光を入射させて、 前記光メモリ索子から外部へ散乱光を出射させ、

前記光メモリ素子の前記複数の小領域からそれぞれ出射される飲乱光を選択的に通過させ、前記一の領域に結像する散乱光を検出して、前記光メモリ素子に記録されている情報を再生することを特徴とする。光メモリ素子の再生方法。

56 【請求項15】 前記複数の小領域の中のいずれか一の

5/11/2006

3 小領域から出射される散乱光のみを通過させることを特 徴とする、請求項14記載の光メモリ素子の再生方法。

【請求項16】 前記一の領域に対向する第1の領域以 外の第2の領域内の小領域の中の所定の複数の小領域か ら出射される散乱光のみを通過させ、前記所定の複数の 小領域からの散乱光が前記一の領域で結像して形成され る一の再生像を検出することを特徴とする、請求項14 記載の光メモリ素子の再生方法。

【請求項17】 前記小領域から出射される散乱光を通 過させるべく。前記小領域よりも大きくなるように前記 10 マスクを部分的に開口させることを特徴とする、語文項 14~16のいずれか1項に記載の光メモリ素子の再生 方法。

【語求項18】 前記一の領域に対向する第1の領域内 の小領域に記録されている情報を再生する際には、前記 第1小領域から出射される散乱光のみを通過させるよう に前記マスクの前記算1小領域に対向する部分を開口さ

前記第1の領域以外の第2の領域内の小領域に記録され される散乱光のみを通過させるように前記マスクの前記 第2小領域に対向する部分から前記一の領域側へずれた 部分を関口させることを特徴とする、譲求項14~17 のいずれか!項に記載の光メモリ素子の再生方法。

【請求項19】 前記マスクが、液晶パネルにより機成 されることを特徴とする。 請求項14~18のいずれか 1項に記載の光メモリ素子の再生方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光メモリ素子、光 30 メモリ素子用再生装置及び光メモリ素子の再生方法に関 し、特に、光導波路デバイスを用いて構成される光メモ リ素子を製造するのに用いて好適の、光メモリ素子、光 メモリ素子用再生装置及び光メモリ素子の再生方法に関 する.

[0002]

【従来の技術】近年、予め所定の散乱光を生じるように パターンが刻まれた平面型(カード型)の光導波路中に 光を導入し、光導波面の外部に画像を結像させる技術が 提案されている(IEEE Photon.Technol.Lett.,vol.9,p p.958-950、JULY1997 等参照)。即ち、例えば図9に模 式的に示すように、光導波路として機能するように屈折 率や瞬厚を調整されたコア(層)101と、このコア層 101を挟む形でその両側(両面部)に設けられた(第 1、第2の) クラッド (層) 102とをそなえて成る力 ード型のスラブ型光導波路デバイス100において、コ ア層101とクラッド層102との界面に微細な凹凸が 存在していた場合、コア層(光導波路)101にレンズ 103を介して光(レーザ光)を導入すると、導入光の 一部がその凹凸部分で散乱し、散乱光がクラッド層10 50 に模式的に示すように、多層構造の光メモリ素子(以

2を通じて外部に出てくる。

【0003】従って、光導波面(光導波路101)から 所定距離に特定の画像が結像するような光の散乱強度と 位組とを計算し、その計算に応じた微細な凹凸パターン を予めコア層101に刻み込んでおけば、光導波面の外 部に所望の画像を結像させることができる。つまり、コ ア居101は情報の記録層として機能することになる。 【0004】そして、例えば、光導液面の外部に出てき た散乱光を上記所定距離に設置したCCD受像機 104 により受光して、結像画像を2次元のディジタルバター ン〔例えば、明暗の2値のバターン。もしくは、明度 (グレイスケール)による多値のパターン等]化してデ ィジタル信号化すれば、既存のディジタル画像処理装置 (図示省略) で結像画像に対し所望の画像処理を実施す ることができる.

【0005】また、例えば図10に模式的に示すよう に、上記のクラッド度102とコア層101とを繰り返 し積層して、光導波路(記録層)101を複数個積層し た場合、取る光導波路101で散乱した光は、別の光導 ている情報を再生する際には、前記第2小領域から出射 20 波路101を憤切ることになるが、通常、コア層101 とクラッド層102の屈折率差が極めて小さいので、そ の散乱光が別の光導波路101に形成された凹凸で再散 乱することは殆ど無く、結像画像が乱れることは無い。 従って、積層數に比例して數多くの画像やバターンを結 俊できることになる。

> 【0006】つまり、光導波路デバイス100はその論 歴教に比例した容量を有する光メモリ素子 (ROM等の 記録媒体〉として使用できるのである。なお、この光メ モリ素子は、理論上では、1座で約1ギガバイト程度の | 容量をもたせることができ、100層程度まで積層する ことが可能であるといわれており、将来的には、勤画像 の記録等に十分対応できる大容置ROMとして使用され ることが有堃視されている。

> 【0007】光導波路デバイス100のコア層101に おける上記の微細な凹凸パターンは、例えば、次のよう な手法で形成される。即ち、まず、図11(A)に模式 的に示すように、(第1の) クラッド層102となる平 板状のガラス等の上にフォトレジストを塗布し、光ある いは電子観等の電光とその現像によりそのガラス(クラ ッド層102)上に、結像させたい像に応じたビット

(凹凸パターン)を形成する。

【0008】その後、その凹凸パターン上にコア層10 1を形成する。これにより、凹凸パターンの形成された コア層101が作製され、このコア層101上にさらに 第2のクラッド層102を形成することにより、1層分 の光導波路デバイス (光メモリ素子) が作製される。そ して、上記と同様に、クラッド圏102上に露光と現像 によって凹凸パターンを形成し、その上にコア層101 を形成することを繰り返し行なうことで、図11(B)

下、「多煙光メモリ」ということがある)100aが作 製される。

【0009】しかしながら、このような露光と現像とを用いた手法では、1厘分の光メモリ素子100の作製に非常に時間及びコストがかかってしまうので、大容量の多層光メモリ100aを作製するには、膨大な時間とコストがかかる。このため、コア厘及びクラッド層を制脂製にすることで、上記の凹凸パターンを簡易に形成できるようにして、限られた体情でより大容量の情報を保持できる光メモリ素子を容易、且つ、安価に実現できるよりにすることが提案されている(特願平11-131512号、特類平11-131513号)。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 光メモリ素子に記録されている情報を再生する場合に は、光メモリ素子からの散乱光(再生像)をドライブに 億えられるCCD受像機(光検出器、受光部)によって 検出することになるが、CCD受像機によって検出でき る範囲(検出範囲)は限られているため、光メモリ素子 のサイズ(光メモリ素子のデータ領域のサイズ)はCC 20 D受像機のサイズ(受光面積)によって制限を受けるこ とだなる

【0011】つまり、例えば光メモリ素子の大容量化を図るべく光メモリ素子のサイズを大きくする場合であっても、CCD受像機のサイズが小さいままでは光メモリ素子からの散乱光の全てを検出することはできないため、結局、光メモリ素子のサイズはCCD受像機のサイズに応じて決められることになる。しかしながら、CCD受像機のサイズはある程度決まっており、CCD受像機のサイズを大きくするのは難しく。また、サイズの大 30 きいCCD受像機は高価であり、入手も難しい。

【0012】このため、CCD受像機のサイズに応じて 決められる光メモリ素子のサイズを大きくすることができず、光メモリ素子の大容量化を図ることができない。 本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、ドライブに備えられるCCD受像機等の光検出器のサイズ(受光面論)の影響を受けることなく、そのサイズ(媒体サイズ:データ領域のサイズ)を大きくして、大容量化を図れるようにした光メモリ素子を提供し、また、このような光メモリ素子に記録されている情報を再生するのに適した光メモリ素子用再生装置(ドライブ)及び光メモリ素子の再生方法を提供することを目的とする。 【0013】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の本発明の 光メモリ素子は、樹脂製コア層と、樹脂製コア層の両面 に積暑された樹脂製クラッド層とからなり、樹脂製コア 層と樹脂製クラッド層との界面の少なくとも一方に情報 用凹凸部を有する光導波部材を、1以上満層させてなる 光メモリ素子であって、情報用凹凸部を有する情報記録 領域が複数の小領域に区分され、複数の小領域から出射 50

される散乱光がいずれも情報記録領域よりも小さい―の 領域に結像して再生像が形成されるように構成されることを特徴としている。

5

【①①14】特に、一の領域に対向する第1の領域以外の第2の領域内の小領域から出射される散乱光の強度が、一の領域において所定強度以上になるように第2小領域の情報用凹凸部が形成されるのが好ましい。好ましくは、情報記録領域は、一の領域に対向する第1の領域とそれ以外の第2の領域とからなり、第2の領域内の小領域(これを第2小領域という)から出射される散乱光の強度が、一の領域において第1の領域内の小領域(これを第1小領域という)から出射される散乱光の強度とほぼ同一になるように、第2小領域の情報用凹凸部を形成する(請求項2)。

【0015】また、前記一の領域に対向する第1の領域以外の第2の領域内の小領域に形成される情報用凹凸部の周期と前記第1の領域内の小領域に形成される情報用凹凸部の周期とを異なるものとする(註求項3)。さらに、複数の小領域には、それぞれ異なる再生像が得られるように情報用凹凸部を形成し、複数の小領域から出射される散乱光によって一の領域に対向する第1の領域では、複数の小領域のそれぞれから出射される散乱光によって一の領域に複数の異なる再生像が形成されるように情報用凹凸部を形成し、第1の領域以外の第2の領域では、所定の複数の小領域から出射される散乱光が一の領域で結像して一の再生像が形成されるように情報用凹凸部を形成するのが好ましい(請求項5)。

【0017】また、複数の小領域間には、それぞれ情報用凹凸部を有しない領域が形成されるように構成するのが好ましい(語求項6)。さらに、複数の小領域同士を一部重複させて構成するのも好ましい(語求項7)。語求項8記載の光メモリ素于用再生装置は、請求項1~7のいずれか1項に記載の光メモリ素子に記録されている情報を再生すべく、光メモリ素子に入射光を入射させ、外部へ出射される散乱光を検出する光メモリ素子用再生装置であって、光メモリ素子から出射され、一の管域に結保する散乱光を検出する光検出器と、光検出器に対向する位置に配設され、光メモリ素子の前記複数の小領域からそれぞれ出射される散乱光を選択的に通過させるべく部分的に開口させうるマスクとを備えることを特徴としている。

【0018】好ましくは、複数の小領域の中のいずれか一の小領域から出射される散乱光のみを通過させるようにマスクを部分的に関口させ、マスクの関口部を通過した散乱光を光検出器によって検出することで、複数の小領域の中のいずれか一の小領域に記録されている情報を再生するように構成する(請求項9)。また、一の領域に対向する第1の領域以外の第2の領域内の小領域の中

(5)

の所定の複数の小領域から出射される散乱光のみを通過 させるようにマスクの複数の部分を開口させ、マスクの 複数の関口部を通過した所定の複数の小領域からの数乱 光によって形成される一の再生像を光検出器によって検 出することで、所定の複数の小領域に記録されている情 報を再生するように構成するのが好ましい(請求項1

【0019】さらに、小領域から出射される散乱光を通 過させるべく、小領域よりも大きくなるようにマスクを 部分的に関口させるように構成するのが好ましい(請求 10 ここでは、樹脂フィルム4も貼り付けたものとしてい 項11)。また、一の領域に対向する第1の領域内の小 領域に記録されている情報を再生する際には、第1小領 域から出射される散乱光のみを通過させるようにマスク の第1小領域に対向する部分を関口させる一方。接数の 小領域の中の第1の領域以外の第2の領域内の小領域に 記録されている情報を再生する際には、第2小領域から 出射される飲乱光のみを道過させるようにマスクの第2 小領域に対向する部分から一の領域側へずれた部分を関 口させるように構成するのが好ましい(請求項12)。 【0020】さらに、マスクを液晶パネルにより構成す 20 るのが好ましい(請求項13)。請求項14記載の光メ モリ素子の再生方法は、請求項1~7のいずれか1項に 記載の光メモリ素子の再生方法であって、光メモリ素子 の光導波部材に入射光を入射させて、光メモリ素子から 外部へ散乱光を出射させ、光メモリ素子の複数の小領域 からそれぞれ出射される散乱光を選択的に通過させ、一 の領域に結像する散乱光を検出して、光メモリ素子に記 録されている情報を再生することを特徴としている。

【0021】好ましくは、複数の小領域の中のいずれか 一の小領域から出射される散乱光のみを通過させるよう 30 にする (請求順15)。また、一の領域に対向する第1 の領域以外の第2の領域内の小領域の中の所定の複数の 小領域から出射される散乱光のみを道過させ、所定の復 数の小領域からの飲乱光が一の領域で結像して形成され る一の再生像を検出するのが好ましい(請求項16)。 【0022】さらに、小領域から出射される散乱光を通 過させるべく、小領域よりも大きくなるようにマスクを 部分的に関口させるのが好ましい(請求項17)。ま た。一の領域に対向する第1の領域内の小領域に記録さ れている情報を再生する際には、第1小領域から出射さ 40 れる散乱光のみを通過させるようにマスクの第1小領域 に対向する部分を開口させる一方、複数の小領域の中の 第1の領域以外の第2の領域内の小領域に記録されてい る情報を再生する際には、第2小領域から出射される飲 乱光のみを通過させるようにマスクの第2小領域に対向 する部分から一の領域側へずれた部分を関口させるのが 好ましい (請求項18)。

【0023】さらに、マスクを液晶パネルにより構成す るのが好ましい(請求項19)。

[0024]

【発明の真旋の形態】以下、本発明の一葉旋形態にかか る光メモリ素子(光メモリ、多層光メモリ)。光メモリ 第千用再生装置及び光メモリ素子の再生方法について、 図1~図8を参照しながら説明する。本真施形態にかか る光メモリ素子 [續層型 (平面型) の光メモリ素子: 續 層導波器型ボログラム素子、MWH素子] の基本的な機 成は、図8に示すように、樹脂製クラッド圏3、樹脂製 コア層2、樹脂製クラット層3からなる光導波部付32 3を複数個領層させた領層体として構成される。なお、

8

【0025】ととで、光導波部材323は、鎖脂製コア 層2と、樹脂製コア層2の両面に積層された樹脂製クラ ッド層3とからなり、かつ、樹脂製コア層2と樹脂製ク ラッド層3との界面の少なくとも一方に凹凸部(情報用 凹凸部) 5を有する。以下、このような光メモリ素子1 ()を構成する積層体の製造方法について説明する。

【0026】始めに、図7(A)に示すように、表面に 結像させたい画像(情報)に応じた所望の凹凸パターン (凹凸形状: ピット)の刻まれたスタンパ1上に、所定 の膜厚となるようにコア村(液状コア樹脂)2′を塗布 する。このコア村2′には、本実施形態では、紫外線 (UV光) を照射することにより硬化する紫外線硬化性 樹脂剤から成るものを使用し、このようにスタンパ1へ 塗布した後、紫外線を照射して完全に硬化させることで 樹脂製のコア層2'を形成する。

【0027】次に、このようにコア村2′を完全硬化さ せた後、図7(B)に示すように、その上に、コア層 2′よりも屈折率の小さい紫外線硬化性樹脂剤から成る クラッド材 (液状クラッド樹脂) 3 a を塗布し、紫外 線際射により硬化させてコア層2′よりも屈折率の小さ い樹脂製クラッド屋3 a′を形成する。その後、図7 (C)に示すように、上記のクラッド層3 a′上に、ク ラッド材3a′と同じクラッド材3b′を塗布し、その 上から支持体となる樹脂フィルム(樹脂製フィルム部 材) 4を、例えばローラ等を用いて加圧しながら貼着。 (ラミネート) していく。つまり、クラッド層3a′に クラッド材3b′を介して樹脂フィルム4をラミネート する。

【0028】かかる状態で、紫外線を照射してクラッド 材3 b′を硬化させれば、クラッド層3 a′と同じ材質 のクラッド層3 b′が形成されると共に、樹脂フィルム 4の接着が行われる。ことで、クラッド層3 a′、3 b' はいずれも同じクラッド材から成るので、1層分の クラッド層3′として機能する。そして、図7 (D) に 示すように、スタンパ1から、上記のコア圏2~とクラ ッド層3′ (3a′, 3b′) と樹脂フィルム4とから なる部材2′3′4を一体に剝離(分離)する。

【0029】次に、図7(E)に示すように、次層の所 50 竺の凹凸パターンが刻まれたスタンパ 1 上に同様にコ (5)

ア層2"、 クラッド層3a"をそれぞれ塗布、繁外線照 射による硬化により形成する。その後、図7 (F) に示 すよろに、上記グラッド層3a"上に、クラッド村3 a ~ と同じクラッド材3b ~ を塗布し、その上から、上 記部村2′3′4を貼着する。紫外線照射により、クラ ッド村3 b * を硬化した後、図7 (G) に示すように、 スタンパ1 "から、上記のコア層2" とクラッド層3" (3 a * 、3 b *) と部村2 * 3 * 4 とを一体に別離す

8に示すような、支持体(基体)としての樹脂フィルム 4の少なくとも一面に、樹脂製クラッド層3と樹脂製コ ア屠2とからなり、かつ、樹脂製クラッド層3と樹脂製 コア層2との界面に凹凸部5を有するクラッド/コア部 材が、2以上債層されて積層体としての光メモリ素子1 ()が形成される。

【0031】ととでは、図8に示すよろに、クラッド/ コア部材はもろいため、支持体としての勧脂フィルム4 上に2以上のクラッド/コア部材を積層させているが、 さらに樹脂フィルム4を接着して2枚の樹脂フィルム4 で飲み込んだ構造としている。これは、光メモリ素子1 0は2枚の制脂フィルム4の間に挟み込んだ方が、その 製造時(特に、光メモリ素子10を切断する際)におい て保護効果が高いからである。なお、樹脂フィルムで挟 み込んだ構造としなくても良く、例えば一方の面のみに 樹脂フィルムを貼着しても良いし、樹脂フィルムを貼着 しなくても良い。

【0032】とのように、2つの支持体を2枚の樹脂で ィルム4とすることで、光メモリ素子10を確実に保護 することができ、また、樹脂フィルム4は適度な柔軟館 30 (可憐性)を有するため、製造時のハンドリング上も好 ましい。なお、2つの支持体は、必ずしも同種の材料に より構成する必要はなく、別種の材料により構成しても 良い。

【0033】なお、ここでは、樹脂製コア層2と、この 樹脂製コア層2の両面に積層された樹脂製クラッド層3 とを備え、これらの樹脂製コア層2と樹脂製クラッド層 3との界面の少なくとも一方に凹凸部5を設けられたス ラブ型光導波路デバイス (光導波部村) 323を、複数 個積層して積層体を形成していると見ることもできる。 【0034】との場合、積層される複数の光導波部材3 23は、隣接する2つの光導液部材間で1層のクラッド 層を兼用している。このため、例えばクラッド層/コア **層/クラッド層/コア層/クラッド層というよう**にクラ ッド層及びコア層を5層積層した場合には、2つの光導 波部村323を積層して積層体としての光メモリ素子1 0を形成したことになる。

【0035】なお、本実能形態では、隣接するクラッド 層を1層として共通に使用しているが、これに限られる ものではなく、クラッド層/コア層/クラッド層の3層 50 好適)で、これらのいずれかを熱延伸或いは溶媒キャス

積層体(光導波部材) 323を基本構成とし、複数の光 導波部材323を樹脂フィルム4等の支持体を挟んで又 は挟まずに論層することもできる。また、光導放部材同 士を接着剤により補煙することもできる。ここで、接着 剤としては、例えば硬化後にクラッド層として機能する クラッド材を使用することができる。

10

【0036】さらに、支持体としての樹脂フィルム4の **裏面側にも同様にクラッド/コア部村を綺層したり、他** の樹脂層を設けたりすることで、積層体のカールを抑え 【0030】以上のプロセスを繰り返すことにより、図 10 る構成とすることもできる。以上の説明において、コア 材2には、塗布時には液体で、その後、硬化させること のできる樹脂であればどのような樹脂を適用してもよい が、好適な物質としては、例えば、繁外級硬化性樹脂な との光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂等が挙げられる。ただ し、上述のごとくスタンパによる転写を行なう場合に は、光硬化性樹脂を適用するのが好ましく、例えば、ア クリル系、エポキシ系、チオール系の各樹脂などが好ま

> 【0037】また、上記のクラッド付3は、透明で屈折 20 率がコア材2よりも僅かに小さい物質(樹脂)であれば 何でも良いが、各種樹脂製のクラッド村3を塗布すると 間便である。光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂等から成るク ラッド材3は樹脂フィルム4との接着性に優れ、好適で ある。また、コア材2、クラッド材3の塗布方法には、 例えば、スピンコート法、ブレードコート法、グラビア コート法、ダイコート法等があるが、塗布膜厚と均一性 を満足すればどのような塗布方法を用いてもよい。

【0038】とこで、光導波部材323を補磨してなる 積層体の厚さは、強度を得るために約0.3mm以上と するのが好ましい。より好ましくは約0.5mm以上で ある。ただし、光カード等の光メモリ(情報記録媒体) としての携帯性を考慮すると約5mm以下とするのが好 ましい。より好ましくは約3mm以下である。本実施形 麼において、支持体は、積層体(光メモリ素子10)を 保持する支持体として機能しうる物質であれば樹脂、金 属など各種のものが用いられるが、製造工程上、貼着 (ラミネート)を行うなど柔軟性が要求される場合は、 樹脂製の支持体とするのが好ましい。各種の硬化性樹脂 を塗布後硬化させたり、樹脂を溶剤に溶かして塗布し乾 40 燥させたりして樹脂製支持体としてもよいが、樹脂フィ ルム4を用いると、スタンパ1上への貼着、剥離を繰り 返して行ないやすく、生産性、作業性の点で好ましい。 【0039】具体的には、樹脂フィルム4は、ポリカー ボネート、アートン (JSR社製) などの非晶質ポリオ レフィン、PET(ポリエチレンテレフタレート)。P EN(ポリエチレンナフタレート)等の光学特性に優れ る(PENはさらに耐熱性にも優れる)熱可塑性の樹脂 フィルムを用いるのが好直(特に、上記のPETやPE Nはいずれも均一な厚みのフィルムを得られやすいので

11 ト等の方法で、例えば100μm以下の厚さにしたもの がよい。

【0040】また、一般に樹脂フィルム4は、その製造 工程で、無機位子等の光学的には散乱体として機能する ものがフィルム内に混入される。フィルム内の歓乱体に よる光の散乱が信号の読み取りに限し問題になる場合、 フィルムの片面にのみクラッド/コア部材が積層されて いる感憶であれば、フィルムとして進光性フィルムを用 いるか、もしくはフィルムとクラッドノコア部村の間に 遮光臓を設けることが好ましい。これにより、樹脂フィー ルム内への光の伝統、もしくはフィルム内での散乱光の 信号光への干渉を防ぐことができる。

【①①41】この場合、支持体そのものを選光性とする ことが、光メモリ素子10の小型化が図れ、製造工程も 簡素化できるためより好ましい。ここで、上記進光性フ ィルム及び遮光膜としては、例えばカーボンを樹脂中に 緯りこんだり、色素を添加したりして作製したPETフ ィルムなどが挙げられる。なお、該遮光フィルムまたは 該進光膜が作用する液長域については、再生に用いる導 入光 (入射光、再生光) の波長を退光することができれ 20 ば十分であり、可視光域全てを遅光する必要はない。遅 光性能については、フィルム厚さ方向で、90%以上の 光を進断することができればよいが、99%以上の光を 遮断することができればより望ましい。

【0042】なお、コア層2、クラッド層3の膜厚につ いては、コア層2、クラッド層3が光導波路として機能 するだけの膜厚であればよく、例えば、使用光波長域が 可規光の波長域であれば、コア層2はおおよそり、5~ 3. 0μm程度になると考えられる。この場合、クラッ ド層3の膜厚に関しては特に制限は無いが、全体の厚さ 30 を薄くすることを考慮すれば、100 mm以下にするの が好ましい。あえて下限を規定するなら、0. 1μm以 上になると思われる。

【0043】グラッド厘3は上記説明のように2層に分 けて形成するのが、膜厚が安定して好ましいが、1層と して形成してもよい。また、上記では、樹脂フィルム4 として、枚葉のフィルムを用いた方式を説明したが、連 続フィルムによる実施も可能である。フィルム上へのコ ア、クラッド村のダイコーター、マイクログラビア、バ ア、クラッド村の硬化等のプロセスを組み合わせること により、支持体上にクラッド/コア部村を箱層した構造 体を作製することができる。また、スタンパとしてロー ルに巻き取り可能な形に加工したロールスタンパを用い ることにより、スタンパからの転写プロセスの生産性を 向上させることも可能である。

【0044】上途のごとく構成された光メモリ素子10 では、例えば、光導波路としてのコア層2に入射端面を 介して光を導入すると、その導入光が界面の凹凸部分で して上下方向(交差する方向)のそれぞれに伝紐(透 過)していき、最終的に光メモリ素子の両面部から外部 へ放出され、凹凸パターンに応じた画像が結像すること になる。

12

【0045】以上のように、本実施形態によれば、積層 されたコア屋2とクラッド層3とがいずれも樹脂製で、 しかも、凹凸の形成されるコア圏(コア材)2に光や熱 等で硬化しうる硬化性樹脂を用いているので、従来のよ うにフォトレジストの露光、現像処理等を用いなくて も、スタンパからの転写によって、コア圏2とクラッド 10 厘3との界面に容易に所望形状の凹凸部5を形成するこ とが可能になる。

【0046】また、クラッド層3の瞬厚を例えば10μ m程度にするととによって、100層積層時にも素子の 膜厚をlmm程度に抑えることが可能となり、多層構造 の実用的な光メモリ素子 10を製造することが可能とな る。従って、多層標準の光メモリ素子10の大量生産が 可能になり、光メモリ素子10を従来よりも容易に(短 期間で〉、且つ、安価に提供することができる。

【0047】ところで、光メモリ素子において記憶容量 をできるだけ多くするためには、光メモリ素子のサイズ (光メモリ素子のデータ領域のサイズ) をできるだけ大 きくする (大面積化を図る)必要がある。また、ハンド リングを考慮すると、光メモリ素子のサイズは所定の大 きさ (例えば2 cm×2 cm) 以上にするのが好まし

【①①48】一方、光メモリ素子に記録されている情報 を読み取る場合には、光メモリ素子からの飲乱光(再生 像)をドライブに備えられるCCD受像機(光検出器。 受光部〉によって検出することになるが、CCD受像機 のサイズ(受光面積)は、所定の大きさ(例えばlcm ×1cm)以上にするのは難しく、CCD受像機のサイ ズを光メモリ素子の全面積をカバーできるように大きく しようとすると、CCD受徐級が高価なものになってし まろし、また、そのような大面積のCCD受像機は入手 も困難である。

【0049】とれらの点を考慮しながら、光メモリ案子 の記憶容置をできるだけ多くしようとすると、光メモリ 素子のサイズ(即ち、データ領域の面積)はCCD受像 ーコータ等による途布、スタンパを加圧した状態でのコ 40 級のサイズ(受光面積)よりも大きくすることになる。 この場合、光メモリ素子に記録されている情報(デー タ) を再生するには、ドライブを、**①複数の小さなサイ** ズのCCD受像機(小面債のCCD受像機)を備えるも のとし、これらの複数のCCD受像機によって光メモリ **素子の全面箱をカバーできるようにするか、又は、②小** さなサイズのCCD受像機(小面額のCCD受像機)を 一つだけ値えるものとし、このCCD受像機を光メモリ 素子の表面に沿って移動させるようにすることが考えら ns.

歓乱しながら伝繍する。このときの散乱光は導入光に対 50 【①①5①】しかしながら、複数のCCD受像機を備え

13

るものとすると、それだけドライブが高価なものとなるため、上述のOのようにドライブを構成するのも好ましくない。さらに、CCD受像機を移動させるようにすると、ドライブは複雑な構造となり、コストもかかることになる。また、CCD受像機を移動させる必要があるため、その分だけドライブの消費電力も大きくなる。このため、上述のOのようにドライブを構成するのも好ましくない。

【0051】これらの点を考慮して、ドライブを安価で、かつ、低清資電力とするためには、小面積のCCD 10 受像機を一つだけ値えるものとして構成し、CCD受像 機と光メモリ素子との間の相対的な位置関係を変えないで光メモリ素子に記録されている情報を再生できるようにしたい。しかし、この場合には、光メモリ素子のサイズ(光メモリ素子のデータ領域のサイズ)はCCD受像機のサイズによって制限を受けることになり、CCD受像機のサイズと同じにするか又はCCD受像機のサイズと同じにするか又はCCD受像機のサイズと同じにするかとであるため、光メモリ素子の記憶容置を多くすることができなくなってしまう。

【0052】とのため、ドライブに備えられるCCD受 20 像機等の光検出器のサイズ(受光面積)の影響を受けることなく、そのサイズ(媒体サイズ;データ領域のサイズ)を大きくして、大容量化を図れるようにしながら、安価で、かつ、低消費電力のドライブによって記録されている情報を確実に読み取ることができるようにすることが望まれている。

【0053】そこで、本実ែ形態では、図1に示すように、上述のようにして1以上の光導波部材323を補層させてなる光メモリ素子10の情報用凹凸部5が形成されている領域(情報が記録されている領域:データ領域、情報記録領域)10Aが、ドライブに備えられるCCD受像機(CCDセンサ、光検出器、受光部)21の受光領域(受光面補)よりも広くなるようにし、かつ、CCD受像機21と光メモリ素子(メディア、媒体)10との相対的な位置関係(相対位置)を変えないで、光メモリ素子10に記録されている情報を再生することができるようにしている。

【0054】具体的には、本実施形態では、図1に示すように、光メモリ素子10のデータ領域10Aを複数の小領域10aに分割し【光メモリ素子10を構成する各光導波部材(基層)323のデータ領域10Aをそれぞれ複数の小領域10aに分割し】、それぞれの小領域10aから出射される散乱光がいずれもデータ領域10Aよりも小さい一の領域(光メモリ素子10から所定距離に位置する領域であって、この領域にCCD受俸機21が設けられる)に結像するようにし、これにより、複数の小領域10aからぞれぞれ異なる再生像が形成されるようにしている。

[0055] つまり、本東鉛形態では、複数の小領域1 0aには、それぞれ異なる再生像が得られるように情報 50

用凹凸部5が形成されており、複数の小領域10aから出射される散乱光によってCCD受像機21の受光領域である一の領域に複数の異なる再生像が形成されるようになっている。なお、ことでは、複数の小領域10aのそれぞれから出射される散乱光によって、それぞれ異なる再生像が形成されるようにしているが、これに限られるものではなく。所定の複数の小領域10aから出射される散乱光によって、一の再生像が形成されるようにしても良い。

【0056】そして、一の領域に結像する再生像を、図

14

1に示すように、ドライブに値えられるCCD受像機2 1によって読み取ることで、光メモリ素子10に記録されている情報が再生されることになる。なお、光メモリ素子10はがラスティックシェル等のパッケージに収納しても良いが、コストを低く抑えるためにはブラスティックシェル等のパッケージは設けないのが好ましい。【0057】そして、例えば光メモリ素子10のデータ領域10Aを1~2cm角とし、これを構成する各小領域10Aを1mm~2mm角として、5mm~1cm角の受光面領を有するCCD受像機21に対して拡大再生

の受光面積を有するCCD受像機21に対して拡大再生するようにしている(図1参照)。なお、光メモリ素子10に記録されている情報は、必ずしも拡大再生しなければならないわけではなく、等倍再生や縮小再生するようにしても良い。

【0058】本実施彩度では、通常どおり、光メモリ素子10の情報用凹凸部5は、光導波方向に対して直交する方向へ出射される歓乱光の強度が最も大きくなるように設計している。このため、図1に示すように、ドライブ20内に光メモリ素子10が挿入・保持された状態

で、CCD受像機21の受光領域である一の領域に対向する(即ち、直下にある)光メモリ素子10の領域(第1の領域)内にある小領域(第1小領域)10×かちの散乱光は、入射光の光導波方向に対して直交する方向へ出射され、散乱光の強度は大きいため、CCD受像機21によって確実に検出することができ、この結果、光メモリ素子10の第1小領域10×に記録されている情報を確実に読み取ることができる。

【0059】なお、光メモリ素子10の第1小領域10 Xは、CCD受像機21に対向する領域としているが、 これはCCD受像機21によって確実に検出しうる程度 の強度を有する散乱光を出射しうる領域をいう。つまり、例えば図1、図2に示すように、ドライブ20に備 えられるCCD受像機21が、このCCD受像機21内 に挿入・保持される光メモリ素子10のデータ領域10 Aの中央部又はその近傍に対向する位置に配設されている場合には、光メモリ素子10のデータ領域10Aの中 央部又はその近傍の小領域10aが第1小領域10A なる。この第1小領域10Xは、1以上の小領域10a により構成される。

【0060】例えば、データ領域10Aを1~2cm角

とし、これを構成する各小領域10aを1mm~2mm 角とし、5mm~1cm角の受光面債を有するCCD受 像綴21に対して拡大再生する場合には、第1小領域1 0Xは1つの小領域10aにより提成される。一方、同 様の条件の下、等倍再生する場合には、第1小領域10 Xは2以上の小領域10aにより提成される。

【0061】一方、光メモリ素子10の情報記録領域を模成する第1小領域10×以外の領域(第2の領域)に含まれる小領域(第2小領域)10×から出射される散乱光のうちCCD受像機21によって検出される(読み取られる)のは、入射光の光導波方向に対して斜めの方向(入射光の光導波方向に直交する方向に対して斜めの方向)へ出射される散乱光であり、散乱光の強度が小さいため、CCD受像機21によって検出するのが難しく。この結果、光メモリ素子10の第2小領域10×に記録されている情報を読み取るのは難しくなる。

【0062】つまり、光メモリ素子10とCCD受像機21との間の間隔(垂直距解)によっても変わるが、再生しようとする情報が記録されている小領域(再生領域)108の位置とCCD受像機21の配設位置とが水 26平方向へ離れすぎていると(マスク22を通過してCCD受像機21によって受光される散乱光の出射角度が急角度になると)、散乱光の強度(パワー)が足りず、CCD受像機21によって読み取られる再生像が暗くなってしまい、再生が困難になる。なお、光メモリ素子10とCCD受像機21との間の間隔(垂直距離)は例えば4~5mm程度である。

【0063】例えば、図1.図2に示すように、ドライブ20に備えられるCCD受像機21が、このCCD受像機21内に挿入・保持される光メモリ素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍に対向する位置に配設されている場合には、光メモリ素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍以外の部分【データ領域10Aの外側部分(外縁側部分)】の小領域10aが第2小領域10Yとなる。

【0064】このように、光メモリ素子10のデータ領域10Aを構成する各外領域10Aから出射される散乱光の強度が中央部又はその近傍と外側部分とで大きく異なる場合には、たとえCCD受像級21側で調整を行なったとしても、光メモリ素子10のデータ領域10Aを40構成する全ての小領域10Aから出射される散乱光を確実に検出できるようにするのは難しい。

【0065】そとで、本実緒形態では、一の領域(即ち、この領域に設けられるCCD受像機21)に対向する第1小領域10X以外の第2小領域10Yから出射される散乱光の強度が、第1小領域10Yから出射される散乱光の強度とほぼ同一になるように、光メモリ索子1のが好ましい。これにより、光メモリ索子1のが好ましい。これにより、光メモリ索子1のが好ましい。これにより、光メモリ索子1のの情報用凹凸部5を形成している。ここでは、第2小領域10Yに形成される情報用凹凸部5の図期と第1小領域10Yに形成される情報用凹凸部5の図期と第1小領域10Xに形成される情報用凹凸部5の図期とが異ない。第2小の散乱光により形成される再

るように形成することで(情報用凹凸部5を構成する凹凸のビッチをずらすことで)、上記一の領域(CCD受像機21)での第1小領域10米からの散乱光の強度と第2小領域10米からの散乱光の強度とがほぼ同一になるようにしている。

16

【0066】具体的には、第2小領域10Yに含まれる 小領域10aが第1小領域10Xに対して入射光の光導 波方向の上後側に位置する場合には、第2小領域10半 に形成される情報用凹凸部5の週期が、第1小領域10 又に形成される情報用凹凸部5の週期よりも長くなるよ うにする一方、第2小領域10Yに含まれる小領域10 8が第1小領域10Xに対して入射光の光導波方向の下 添測に位置する場合には、第2小領域10Yに形成され る情報用凹凸部5の国籍が、第1小領域10米に形成さ れる情報用凹凸部5の周期よりも短くなるようにする。 【0067】通常、小領域10aからの飲乱光は光導波 方向に対して直交する方向へ所定距離だけ離れた直上の 領域(小領域10gに対向する領域)で最大の強度とな るように構成するが、特報用凹凸部5の周期を変えるこ とで散乱光の出射角度を変えることができるため、これ により、小領域10 aからの散乱光が直上の領域以外の 領域で最大の強度となるようにすることができる。

【0068】例えば、入射光の波長入が678nm、コア層の屈折率nが約1.5の場合に、情報用凹凸部5の 園期を447nm(= \(\lambda\) / n) とすると、散乱光は直上 (コア層に対して90度の方向)で最大強度となる。ここで、情報用凹凸部5の周期を540nmとすると、散乱光の出射角度が入射光の導波方向側に約10度傾き、散乱光が直上の領域から入射光の導波方向側にずれた領域で最大強度となる一方、情報用凹凸部5の周期を380nmとすると、散乱光の出射角度が入射光の導波方向とは逆方向側(入射端面側)に約10度傾き、散乱光が直上の領域から入射光の導波方向とは逆方向側にずれた領域で最大強度となる。

【0069】上記の機成により、第2小領域10分からの散乱光の強度が、直上の領域よりも斜め方向に位置する領域の方が大きくなるようにして、第1小領域10分からの散乱光の強度と第2小領域10分からの散乱光の強度とがCCD受像機21上では間一になるようにしている。この場合、光メモリ案子10のデータ領域10人の外側(外線側)になるほど、CCD受像機21によって読み取ることのできる散乱光は急角度に出射されたものとなり、散乱光の強度が小さくなるため、光メモリ素子10のデータ領域10人の中央部側よりも外側大強度となるように、情報用凹凸部5の周期を段階的に変えるのが好ましい。これにより、光メモリ素子10のデク領域10人のどの位置から出射される散乱光の強度もCCD受像機21では等しくなるようになることがで

17 生像をCCD受像級21によって確実に読み取ることが できるようになる。

【0070】なお、ここでは、第1小領域10米からの 飲乱光の強度と第2小領域10Yからの飲乱光の強度と がほぼ同一になるようにしているが、これに限られるも のではなく、CCD受像機21によって再生像を確実に 読み取ることができる程度に第2小領域10 Yからの飲 乱光の強度が大きくなるように、CCD受像機21によ って検出される散乱光の出射角度に応じて第2小領域1 ① Yに形成される情報用凹凸部5の周期を異なるものと すれば良い (周期を長く又は短くすれば良い)。

【0071】つまり、一の領域(即ち、この領域に設け ちれるCCD受像機21) に対向する第1小領域10X 以外の第2小領域10Yから出射される散乱光の強度 が、一の領域において所定強度以上になるように第2小 領域10Yの情報用凹凸部5を形成すれば良い。とこ で、所定強度は、CCD受像機21によって検出可能な 強度として設定される。

【0072】次に、上述のように構成される光メモリ素 子10に記録されている情報を再生するドライブ(光メ 20 モリ素子用再生装置、光メモリ素子用読取装置)20に ついて、図2を参照しながら説明する。なお、図2では ドライブ20の主要な構成要素のみを示している。本実 施形感にかかるドライブ20は、光導波部材323に入 射光を入射させ、外部へ出射される散乱光を検出するこ とで、光メモリ素子10に記録されている情報を再生す るものであり、図2に示すように、光メモリ素子10か ち出射され、一の領域に結像する散乱光を検出するCC D受像機(CCDセンサ、光検出器、受光部)21と、 このCCD受像機21に対向する位置に配設され、光ス モリ素子10のデータ領域10Aを構成する複数の小領 域108のそれぞれから出射される散乱光を選択的に通 過(透過)させうるように部分的に開口されるマスク2 2とを備えるものとして構成される。

【0073】なお、ドライブ20は、当然のことなが ち、光源(再生光源)、この光源からの光(入射光)を 光メモリ素子10を構成する光導液部村323のコア層 2に入射させるための集光部(集光レンズ)、CCD受 像様21により検出された信号を処理する信号処理部 (画像処理部) 等も備えられている。そして、光メモリ 素子10に記録されている情報を再生する際には、光源 からの入射光を、光メモリ素子10を構成する光導液部 材323のコア層2の幅方向の全長にわたって延びるよ うに成形し、集光部によって入射總面(例えば90度入 射端面や4.5度入射端面)の再生しようとする情報が記 録されている光導波部材(再生光導波部材)323のコ ア層部分に集光させて入射させて、光メモリ素子10の データ領域10Aの全面から散乱光を出射させ、再生し ようとする情報が記録されている小領域(再生小領域)

関口部22Aとし、この開口部22Aを通過した飲乱光 のみをCCD受像機21によって検出することで、再生 しようとする小領域10aに記録されている情報を再生 **ずるようになっている。**

18

【0074】とこでは、CCD受像機21は、光メモリ 素子 10の所望のデータ(情報)を記録するデータ領域 10Aの面積 (例えば1cm角~2cm角程度) よりも 小さい面積(例えば5mm角~1cm角程度)の受光額 域(受光面論)を有するものとしている。このCCD受 像機21は、図1、図2に示すように、ドライブ20内 に挿入・保持される光メモリ素子10のデータ領域10 Aの中央部又はその近傍に対向する位置に配設される。 このため、第1小領域10米は、光メモリ素子10のデ ータ領域10Aの中央部又はその近傍に位置する小領域 10aにより構成され、第2小領域10Yは、光メモリ 素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍以外 に位置する小領域 [中央部又はその近傍の外側部分(外 縁側部分) に位置する小領域] 10 a によって構成され

【0075】なお、ここではCCDセンサ21を用いて いるが、これに限られるものではなく、例えばCMOS センサ等を用いても良い。マスク22は、ドライブ20 内に挿入・保持された光メモリ素子10とCCD受像機 21との間に位置する。このマスク22のサイズは、光 メモリ素子10(光メモリ素子10のデータ領域10 A)の略全域をカバーしろるものとされる。

【0076】ことでは、マスク22は例えば液晶パネル 等により構成される。このようにマスク22を波晶パネ ルにより構成すれば、一般に、液晶パネルの一画素の大 きさは光メモリ素子10の小領域10aの大きさよりも 十分に小さいため、例えば再生しようとする小領域10 aの大きさ、マスク22と光メモリ素子10との間の間 隔。アライメント等を考慮して、マスク22の開口部2 2 Aの大きさを任意に調整できることになる。

【0077】本実施形態では、複数の小領域10aのい ずれか―の領域から出射される飲乱光のみを通過させう るように、マスク22を部分的に関口させて関口部22 Aとするようになっている。このため、ドライブ20に は、再生しようとする小領域108の位置に応じてマス ク22と部分的に関口させて関口部22Aとする制御 (開口制御)を行なう制御部が備えられている。

【0078】ととでは、図2~図4に示すように、再生 しようとする情報が記録されている小領域10aに対向 する位置 (小領域10 aの真上又は真下の位置)でマス クを部分的に開口させて開口部22Aとする。ここで は、光メモリ素子10のデータ領域10Aを構成する各 小領域10aの大きさは1mm角~2mm角としてお り、マスク22の関口部22Aの大きさも、これと同程 度の大きさにしている。なお、マスク22の関口部22 10aの位置に応じてマスク22を部分的に関口させて「50」Aの大きさは、これに限られるものではなく、この大き (11)

さを上限として、さらに小さくしても良い。一方、下限 は任意であるが、0、5mm角~0、7mm角程度とす るのが好ましい。

19

【0079】一方、光メモリ素子10の第2小領域10 Yに記録されている情報を再生する際には、第2小領域 10 Yに対向する位置(小領域10 aの真上又は真下の 位置)でマスク22を部分的に関口させて関口部22A としても、第2小領域107から出射される散乱光はマ スク22によって遅られてしまい、CCD受像機21に よって確実に検出することができない。

【0080】とのため、図5に示すように、再生しよう とする情報が記録されている小領域10aが光メモリ素 子10のデータ領域10Aの外側(外繰側)である場合 には、マスク22の関口部22Aの位置を小領域10a に対向する位置 (小領域1) a の真上又は真下の位置) からずらした位置とし、開口部22Aの大きさ(面積) も大きくするのが好ましい。特に、再生しようとする情 報が記録されている小領域10aが光メモリ素子10の データ領域10Aの外側(外縁側)になるほど、マスク 置(小領域10aの真上又は真下の位置)から段階的に 少しづつずらすのが好ましい。

【0081】また、マスク22の関口部22Aは、再生 しようとする情報が記録されている小領域10aの大き さ(面積)に応じて適切な大きさ(面積)とする必要も ある。これは、マスク22の関口部22Aの大きさが大 きいと、再生しようとする小領域10aに隣接する領域 から出射される散乱光もマスク22の開口部22Aを通 過してしまい。この隣接する小領域10aに記録されて いる情報も再生されてしまうからである。一方、マスク 22の関口部22Aの大きさが小さいと、再生しようと する小領域 1 () a の一部分から出射される散乱光だけし かマスク22の開口部22点を通過せず、再生しようと する小領域10aに記録されている情報の全てを再生で きないことになるからである。

【0082】実際には、ドライブ20内に挿入・保持さ れる光メモリ素子10とマスク22とのアライメントを とる必要があり、このアライメントをとるのは難しく、 また、正確にアライメントをとるには時間がかかってし まう場合もある。このような点を考慮すると、再生しよ うとする情報が記録されている小領域10 aの大きさ (面積)よりもマスク22の関口部22Aの大きさ(面 績) の方が大きくなるようにして、アライメントエラー を許容できるようにするのが好ましい。

【0083】とのように、再生しようとする情報が記録 されている小領域10 aの大きさ(面積)よりもマスク 22の関口部22Aの大きさ(面積)を大きくすると、 上述したように、再生しようとする情報が記録されてい る小領域10 a に隣接する領域から出射される散乱光も マスク22の開口部22Aを通過してしまい、この瞬接 50 お. ここでは、上述のように、入射光(例えば入射レー

20 する小領域10aに記録されている情報も再生されてし まうおそれがある。

【0084】 このため、図3(A)に示すように、光メ モリ素子10のデータ領域10Aを複数の小領域10a に分割(区分)し、各小領域108毎に異なる情報を記 録する際に、各小領域10aを間隔をあけて設けておく ことで [各小領域] () a 間に情報用凹凸部5を有しない 領域 (マージン)を設けておくことで〕、再生しようと する情報が記録されている小領域!i)aに隣接する小領 10 域 1 0 a からの散乱光がマスク 2 2 の開口部 2 2 A を通 過しないようにするのが好ましい。

【0085】ここで、情報用凹凸部5を有しない領域 (マージン) は約0.05~0.2 m m程度とするのが 好ましく、最も好ましくはり、1mm程度とする。な お、光メモリ素子10には保護圏等が設けられており、 光メモリ素子10とマスク22とを密着させたとして も、光メモリ素子10のコア層2とマスク22との間に は間隔ができてしまうため、特に、光メモリ素子10に 記録されている情報を拡大再生する場合には、光メモリ 22の関口部22Aの位置を小領域10aに対向する位 20 素子10の再生しようとする光導波部村323のコア圏 2とマスク22との間の間隔を考慮してマスクの開口部 22Aの大きさを設定する必要がある。

> 【0086】以下、上述のような条件を満たす光メモリ 素子10の─具体例について説明する。例えば、3 µ m ピッチ、400万画素(例えば2452×1630: 7. 4mm×5mm)のCCD受像機21を使用し、こ の?. 4 mm×5 mmの受光領域を有するCCD受像機 21によって、光メモリ素子10のデータ領域10A (例えば2cm×2cm)を細分化した各小領域10a のそれぞれから出射される散乱光によって形成される耳 生像を読み取ることで多重再生する。

【0087】とこでは、光メモリ素子10のデータ領域 10AよりもCCD受像機21の受光領域が小さく、デ ータ領域10Aを細分化した複数の小領域10aのそれ ぞれから出射される散乱光によって形成される再生像を 読み取るものであるため、「縮小・多重」方式の再生方 法という。このように、光メモリ素子10のデータ領域 10Aを250個の小領域10aに分割して、それぞれ の小領域 1 () a に異なる再生像が得られるように情報を 40 記録する場合 (250多重する場合) . 例えば光メモリ 素子10のデータ領域10Aを2cm角(2cm×2c m) とすると、各小領域10gの大きさ(面積)は1. 6 m m 角(1.6 m m×1.6 m m)となる。

【0088】そして、マスク22と光メモリ素子10の 光導波部材323のコア層2との間の距離を100μm 程度として、3倍~5倍の拡大再生を行なう場合には、 機械的なアライメントは±0. lmm程度が限界である ため、マスク22の1個の開口部22Aの大きさは約 1. 3mm角(1. 3mm×1. 3mm) とする。な

(12)

ザ)を、光メモリ素子10を構成する光導波部针323のコア屋2の幅方向全長にわたって延びるように成形して入財させており、これによれば、入射光の照射位置を移動させる必要がなく、例えば光瀬や最光部等を移動させる機構を設ける必要がないという点では好ましいが、再生しようとする光導波部针323のコア屋2に十分な強度の入射光を確実に入射させる必要があるため、入射光を光メモリ素子10の幅方向の全長にわたって延びるように細長く成形するといっても、これには限界がある。

【0089】この場合、図2に示すように、再生しようとする小領域108に対応する位置(光メモリ素子10の帽方向位置)だけに入射光(例えば入射レーザ)を入射させれば良い。ここで、本実施形態では、光メモリ素子10のデータ領域10Aを構成する複数の小領域10aの中のいずれか一つの小領域10aに記録されている情報のみを選択的に再生するため、再生しようとする小領域10aを構成する光導液部材323のみに入射光が入射されるようにすれば良い。

【0090】との場合、再生しようとする小領域10a 20の位置に応じて入射光の照射位置(入射位置)を移動させることになり、光メモリ素子10(光メモリ素子10の入射端面)と入射光の照射位置とのアライメントをとることが必要になるため、簡単にアライメントをとれるようにするためには、再生しようとする小領域10aの幅(光メモリ素子10の帽方向の長さ:例えば1mm~2mm程度)よりも大きい帽(例えば2mm程度)に成形した入射光(例えば入射レーザ)を入射させるのが好ましい。これによれば、光のパワーの小さい光源を使うことができるため好ましい。この結果、光学系の設計の 30幅も広がることになる。

【0091】上述のように、本実施形態では、ドライブ20にマスク22が設けられており、その一部分のみを関口させることができるようになっているため、マスク22の関口部22Aの位置を変えることで、光メモリ素子10のデータ領域10Aを構成する複数の小領域10aに記録されている情報をそれぞれ別々に再生(多重再生)できることになる。また、小面積のCCD受像機21を一つだけ設け、CCD受像機21を移動させることなく、光メモリ素子10のデータ領域10A(例えば1cm角~2cm角程度)に記録されている情報を全て再生できることになる。

【0092】これにより、マスク22の一部(所定領域)を関口させ、このマスク22の開口部22Aを通過した散乱光が結像して形成される再生像をCCD受像級21で検出することで、ドライブ20内に挿入・保持された光メモリ素子10のデータ領域10AとCCD受像級21との相対的な位置関係(相対位置)を変えないで、光メモリ素子10のデータ領域10Aを構成する各小領域10aに記録されている情報をそれぞれ独立に再50

生できることになる。

【0093】次に、上述のように模成される光メモリ素子10の再生方法、即ち、光メモリ素子用再生装置の再生助作について説明する。まず、例えば図3(A)に示すように、光メモリ素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍に位置する一の小領域10aa(第1小領域10Xに含まれる小領域10a)に記録されている情報を再生する場合、この一の小領域10aaに対向する位置(ここでは真上の位置)でマスク22が開口されるように、マスク22の中央部又はその近傍に位置する一の領域が関口部22Aとされる。

22

【0094】また、例えば図3(B)に示すように、光メモリ素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍に位置する他の小領域10ab(第1小領域10Xに含まれる小領域10a)に記録されている情報を再生する場合、この他の小領域10abに対向する位置(ここでは真上の位置)でマスク22が開口されるように、マスク22の中央部又はその近傍に位置する他の領域が関口部22Aとされる。なお、図3(A)、(B)では、20光メモリ素子10に記録されている情報を拡大再生する場合を示している。

【0095】これにより、光メモリ素子10の情報用凹凸部5で散乱した散乱光のうち、主に入射光の光導波方向に対して直交する方向へ出射される光がマスク22の閉口部22Aを通過するため、この散乱光が結像して形成される再生像がCCD受像機21によって確実に読み取られることになる。また、このようにマスク22の閉口部22Aを1箇所のみとすることで、マスク22の駆動副制(駆動方式)を簡略化することができる。

【0096】一方、例えば図4に示すように、光メモリ 素子10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍以外 の外側部分(外細側部分)に位置する小領域10ac (第2小領域10Yに含まれる小領域10a)に記録されている情報を再生する場合、この小領域10acに対 向する位置 (ここでは真上の位置)でマスク22か関口され、マスク22の中央部又はその近傍以外の外側部分 (外細側部分)に位置する領域が関口部22Aとされる。

【0097】とれにより、光メモリ素干10の信報用凹凸部5で飲乱した飲乱光のうち光澤敬方向に対して斜めの方向へ出射される光のみがマスク22の閉口部22Aを通過し、この散乱光が結像して形成される再生像がCCD受像機21によって読み取られる。ここでは、上述のように、光メモリ素子10の小領域10ac(第2小領域10Yに含まれる小領域10a)に形成される情報用凹凸部5は腐期を長く(又は短く)してあり、これにより、飲乱光の強度が十分に確保されるため、このように光メモリ素干10のデータ領域10Aの中央部又はその近傍以外の外側部分(外線側部分)に位置する小領域10ac(第2小領域10Yに含まれる小領域10a)

に記録されている情報であっても確実に再生できること になる。また、とのようにマスク22の関口部22Aを 1箇所のみとすることで、マスク22の駆動制御(駆動 方式)を随略化することができる。

【0098】なね、図5に示すように、再生しようとす る情報が記録されている小領域 1 () a が光メモリ素子 1 ①のデータ領域10Aの外側部分(外線側部分)にある 場合に、光メモリ素子10の第2小領域10Yからの散 乱光がマスク22によって遮られることなく、確実にC CD受像機21によって受光されるようにするために は、マスク22の関口部22Aの位置を再生小領域10 aに対向する位置(小領域10aの真上又は真下の位 置) から少しずらした位置にするのが好ましい。

【①①99】したがって、本実施形態にかかる光メモリ 素子10によれば、ドライブ20に備えられるCCD受 像機21のサイズ(受光面積)の影響を受けることな く、そのサイズ(媒体サイズ;データ領域のサイズ)を 大きくして、大容量化を図れるようにしながら、安価 で、かつ、低消費電力のドライブ20によって、記録さ れている情報を確実に読み取って再生できるという利点 20 に位置する第2小領域10Yに情報を記録する場合に がある。

【0100】また、本真餡形態にかかる光メモリ素子用 再生装置 (ドライブ) 20 によれば、ドライブ20内に 挿入・保持された光メモリ素子10の中央部又はその近 傍に対向する位置に、小面積のCCD受像機21を一つ だけ固定的に配設されたものとすれば良く、このような 光メモリ素子10に記録されている情報を再生するのに 適した、安価で、かつ、低消費電力のものを提供できる という利点がある。

【0101】さらに、本実能形態にかかる光メモリ素子 30 の再生方法によれば、このような光メモリ素子10に記 録されている情報を再生するのに適した光メモリ素子の 再生方法を提供できるという利点がある。なお、上述の 実施形態では、上述の光メモリ素子10のデータ領域1 ①Aの中央部又はその近傍に位置する第1小領域10X と同様に、光メモリ素子10のデータ領域10Aの中央 部又はその近傍以外の外側部分(外海側部分)に位置す る第2小領域10Yを構成する一の小領域10aに情報 を記録し、情報を再生する際にはマスク22の1箇所の みを開口させて開口部22Aとするようにしている。 【0102】そして、光メモリ素子10のデータ領域1 ① Aの中央部又はその近傍以外の外側部分(外縁側部)

分) に位置する第2小領域10Yに形成する情報用凹凸 部5の国期を長くし(又は短くし)、入射光の光導波方 向に対して斜め方向に出射する散乱光の強度を大きくす ることで、CCD受像級21によって再生像を確実に読 み取ることができるようにしている。

【0103】しかしながら、飲乱光の出射角度に応じて 飲乱光の強度(パワー)が調整され、再生像が明るくな が、このように、情報用凹凸部5の凹凸のピッチを変え たとしても、光メモリ素子 10の幅方向へ向けて斜めに 出射される飲乱光の強度 (パワー) を上げることはでき ない。

【0104】つまり、上述の実施形態のように、情報用 凹凸部5の周期を変えることで、CCD受像級21に対 して光導波方向の上流側及び下流側に位置する小領域1 () a から光導波方向に対して斜め方向 (光導波方向に直 交する方向に対して斜め方向)へ出射される散乱光の強 19 度を大きくすることができるとしても、CCD受像機2 1に対して光導波方向の両側(左側及び右側)に位置す る小領域10aから光メモリ素子10の幅方向へ向けて 斜めに出射される散乱光の強度を上げることはできな

【0105】また、情報用凹凸部5の周期を変えるだけ では、情報用凹凸部5によって散乱される散乱光を確実 に結像させるのは難しいため、鮮明な再生像を得るのは 難しい。このため、光メモリ素子10のデータ領域10 Aの中央部又はその近傍以外の外側部分(外縁側部分) は、所定の複数 (ここでは4つ) の小領域10 a に分散 させて情報を記録する。そして、この情報を再生する段 には、所定の複数の小領域10gの位置に応じて、例え は図6に示すように、マスク22の複数箇所(ここでは 4箇所)を関口させて関口部22Aとし、これらの複数 (ここでは4つ)の関口部22Aを道過し、1点に結像 する散乱光によって1つの再生像が形成されるようにし て、これをCCD受像級21によって読み取ることで、 第2小領域10Yに記録されている情報を再生するよう にすれば良い。

【0106】との場合、光メモリ素子10の第2小領域 10 Yの所定の複数箇所(とこでは4箇所)に形成され るそれぞれの情報用凹凸部5によって散乱される散乱光 が合わさって1つの再生像が形成されるように、光メモ リ素子10の第2小領域10Yに情報用凹凸部5を形成 しておけば良い。特に、第2小領域10Yの中でも光メ モリ素子1()データ領域1()Aの外側(外縁側)になる ほど、出射角度が急になり、散乱光の強度が小さくな り、かつ、再生像を結像させにくくなるため、光メモリ | 素子10のデータ領域10Aの外側(外縁側)になるほ と情報を記録する箇所の数を増やすのが好ましい。 【0107】なお、第1小領域10Xでは、複数の小領

域10aのそれぞれから出射される散乱光によって一の 領域に複数の異なる再生像が形成されるように情報用凹 凸部5を形成しておけば良い。これにより、光メモリ素 子10の第2小領域10平に形成される情報用凹凸部5 によって飲乱され、CCD受像機21により受光される **散乱光の強度(パワー)を大きくすることができるとと** もに、情報用凹凸部5によって飲乱される飲乱光を確実 り、これにより、再生像が確実に再生されることになる「50」に結像させ、鮮明な再生像が得られるようにすることが

特闘2003-7072

26

できる。

【0108】また、上述の実施形態では、第1小領域1 ①Xと第2小領域10Yとは同じ大きさとしているが、 これに限られるものではなく、例えば、光メモリ素子1 0のデータ領域10Aの中央部又はその近傍以外の外側 部分(外縁側部分)に位置する第2小領域10Yの大き さを、第1小領域10Xよりも大きく形成しても良い。 例えば、第2小領域10Yを第1小領域10Xの2倍, 4倍の大きさにしても良い。

25

散乱光によって1つの再生像が形成されるようにすれ は、CCD受保機21により受光される飲乱光の強度 (パワー) を大きくずることができるとともに、鮮明な 再生象が得られるようにすることができる。また、上述 の実施形態のものと同様に、データ領域10Aの外側 (外繰側) になるほど小領域10 aの面積が大きくなる ようにして飲乱光の強度(パワー)を大きくするのが好

【0110】なお、上述の実施形態では、光メモリ素子 10のデータ領域10Aを複数の小領域10aに分割 (区分) し、各小領域10a毎に異なる情報を記録する 際に、各小領域10 a間に情報用凹凸部5を有しない領 域 (マージン)を設けることで、マスク22と光メモリ 素子10との間の距離の影響によって各小領域10a間 でクロストークが生じるのを防ぐようにしているが、ク ロストークを防ぐ方法はこれに限られるものではない。 【0111】例えば、各小領域10aの境界付近の領域 ではそれぞれの小領域10aに記録すべきデータ(情 報)を重ねて書き込んでしまう方法(データを重複させ る方法) もある。つまり、一つの小領域10 a に情報用 30 凹凸部5を形成する場合。その小領域1()aから得たい 再生像をもとに計算を行なえば、小領域10 a を構成す る各セルにどのような国期、位相、長さ等を持った情報 用凹凸部5を形成すべきかを一截的に求めることができ るので、これに基づいて情報用凹凸部5を形成する。 【0112】ここで、各小領域10aの境界付近のデー タを重複させて書き込む領域では、両方の小領域 1 () a

の再生像に寄与するような周期、位相、長さ等を持った 情報用凹凸部5を形成する。これも、両方の小領域10 aの再生像をもとに計算を行なえば一義的に求められ る。但し、データを重複させて書き込む領域は、各小領 域10aの境界部近傍の領域にとどめるのが好ましい。 つまり、各小領域10 aから得られる再生像への寄与が もともと小さい領域にとどめるのが好ましい。これは、 データを重復させて書き込む領域があまりに大きかった り、小領域10aの中心部に近い側にあったりすると、 再生像が鮮明でなくなるおそれがあるからである。この ため、データを重復させて書き込む領域(データ重複領 域) は、例えば(). () 5~(). 2 mm程度とするのが好 悪しい。

[0113]

【発明の効果】請求項1~7記載の本発明の光メモリ素 子によれば、ドライブに储えられるCCD受像機等の光 検出器のサイズ (受光面積) の影響を受けることなく、 そのサイズ(媒体サイズ、データ領域のサイズ)を大き くして、大容量化を図れるという利点がある。

【0114】詰求項8~13記載の本発明の光メモリ素 子用再生装置によれば、請求項1~7記載の光メモリ素 子に記録されている情報を再生するのに適した。安価 【0109】との場合、大きい第2小領域10分からの 10 で、かつ、低消費電力なものを提供できるという利点が ある。請求項14~19記載の本発明の光メモリ素子の 再生方法によれば、請求項1~7記載の光メモリ素子に 記録されている情報を再生するのに適した光メモリ素子 の再生方法を提供できるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子の全 体構成を示す模式的斜視図である。

【図2】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子用再 生装置の構成を説明するための模式的斜視図である。

【図3】(A)、(B)は、本発明の一実施形態にかか る光メモリ素子の再生方法を説明するための模式図であ

【図4】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子の再 生方法を説明するための模式図である。

【図5】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子の再 生方法を説明するための模式図である。

【図6】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子の再 生方法を説明するための模式図である。

【図7】(A)~(G)は、本発明の一実施形態にかか る光メモリ素子を構成する積層体の製造方法を説明する ための模式的断面図である。

【図8】本発明の一実施形態にかかる光メモリ素子を櫓 成する綺層体の標層構造の一例を説明するための模式的 断面図である。

【図9】従来の光メモリ素子の動作原理を説明するため の模式的斜視図である。

【図10】従来の光メモリ素子の動作原理を説明するた めの模式的斜視図である。

【図11】(A)、(B)はいずれも従来の光メモリ素 40 子の動作原理を説明するための模式的斜視図である。

【符号の説明】

1 スタンパ

2、2A、2B コア層 3. 3A, 3B クラッド層

4. 樹脂フィルム (支持体)

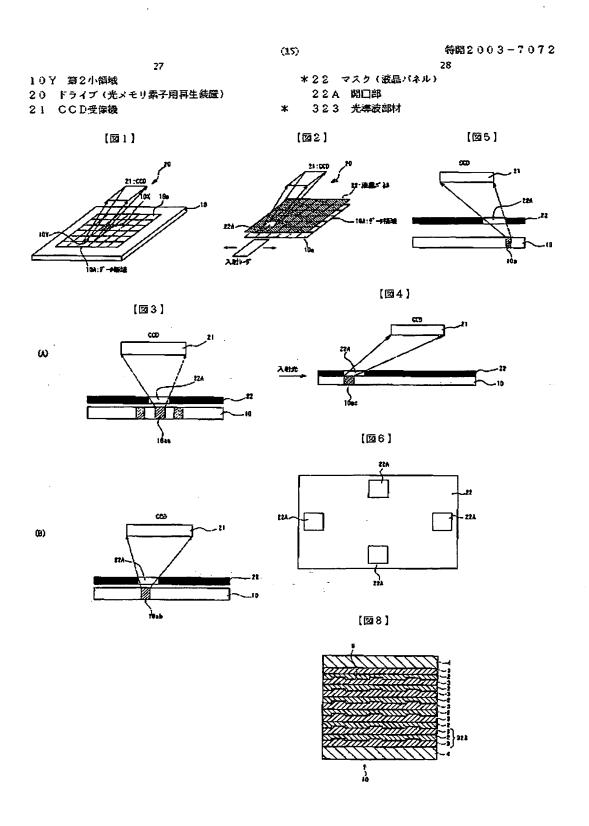
5 凹凸部

10 光メモリ素子

10A データ領域 (情報記録領域)

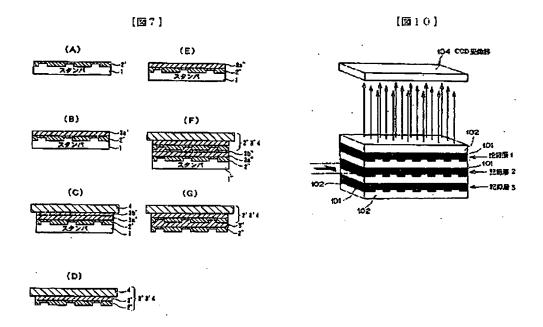
10a, 10aa, 10ab, 10ac 小領域

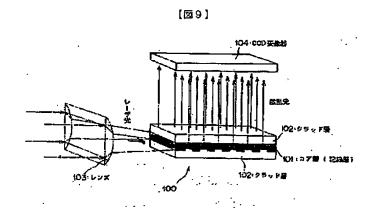
50 10X 第1小領域



(16)

特闘2003-7072

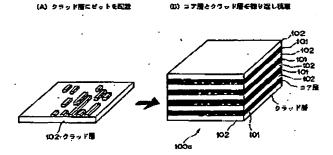




(17)

特関2003-7072

[図11]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

C
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.